

**КТ8270А**

кремниевый биполярный  
эпитаксиально-планарный  
п-р-п транзистор

**Назначение**

Транзистор п-р-п кремниевый эпитаксиально-планарный в пластмассовом корпусе предназначен для использования в пускорегулирующих устройствах осветительной аппаратуры, схемах преобразователей напряжения и другой радиоэлектронной аппаратуре, изготавливаемой для народного хозяйства

**Зарубежные прототипы**

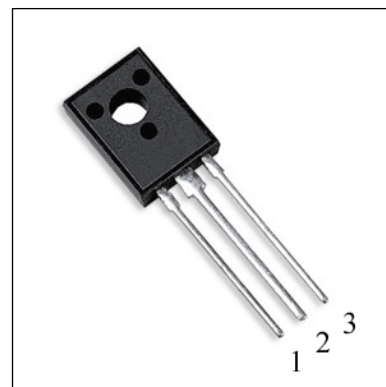
- прототип MJE13001

**Обозначение технических условий**

- АДБК. 432140. 093 ТУ

**Особенности**

- диапазон рабочих температур от - 45 до + 125 °С

**Корпусное исполнение**

- пластмассовый корпус КТ-27 (ТО-126)

**Назначение выводов**

Вывод	Назначение
№1	База
№2	Коллектор
№3	Эмиттер

**Таблица 1. Основные электрические параметры КТ8270А при  $T_{\text{окр. среды}} = + 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$** 

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Гран. напряжение колл.-эмиттер	* $U_{кэ\text{ гр.}}$	В	$I_k=10 \text{ мА}, I_b=0$	400	-
Обратный ток коллектор-эмиттер ( $U_{кэ}=0$ )	* $I_{кэк}$	мкА	$U_{кэ}=600\text{В}, R_{эб}=0$	-	100
Обратный ток коллектор-эмиттер	* $I_{кэо}$	мкА	$U_{кэ}=400\text{В}, R_{эб}=\infty$	-	100
Обратный ток эмиттера	$I_{эбо}$	мкА	$U_{эб} = 9 \text{ В}$	-	100
Статический коэффициент передачи тока	* $h_{21E}$		$U_{кэ} = 20 \text{ В}, I_k = 200 \text{ мА}$	10	90
			$U_{кэ} = 5 \text{ В}, I_k = 1 \text{ мА}$	8	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	* $U_{кэ(\text{нас})}$	В	$I_k = 200\text{мА}, I_b = 50 \text{ мА}$ $I_k = 50 \text{ мА}, I_b = 10 \text{ мА}$	-	1,5 0,5
Напряжение насыщения база-эмиттер	* $U_{бэ(\text{нас})}$	В	$I_k = 200 \text{ мА}, I_b = 50 \text{ мА}$	-	1,3

\* -  $t_i \leq 300\text{мкс}, Q \geq 100$

**Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ8270А**

Параметры	Обозначение	Единица измер.	Значение
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер ( $R_{эб} = 0$ )	$U_{кэк\text{ max}}$	В	600
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор- эмиттер ( $R_{эб} = \infty$ )	$U_{кэ\text{ max}}$	В	400
Максимально допустимое постоянное эмиттер-база	$U_{эб\text{ max}}$	В	9
Максимально допустимый постоянный ток коллектора	$I_k\text{ max}$	А	0,5
Постоянный ток базы	$I_b\text{ max}$	А	0,3
Рассеиваемая мощность коллектора	$P_k\text{ max}$	Вт	7
Тепловое сопротивление переход-корпус	$R_t\text{ пер-кор.}$	$^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	17,8
Температура перехода	$T_j$	$^{\circ}\text{C}$	150



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>